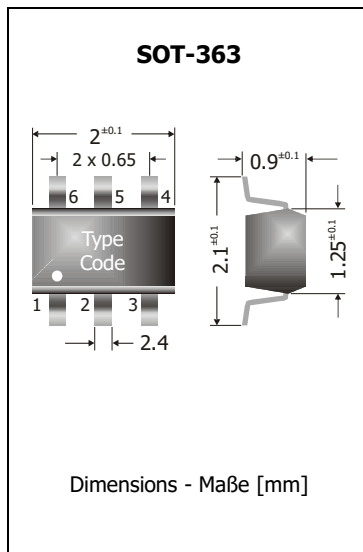


BC672S
SMD General Purpose NPN Transistors
SMD Universal-NPN-Transistoren

$I_C = 50 \text{ mA}$
 $h_{FE} = 100 \dots 200$
 $T_{jmax} = 150^\circ\text{C}$

$V_{CE0} = 18 \text{ V}$
 $P_{tot} = 150 \text{ mW}$

Version 2020-07-10

**Typical Applications**

Signal processing,
 Switching, Amplification
 Commercial grade ¹⁾

Features

Two transistors in one package
 General Purpose
 Compliant to RoHS, REACH,
 Conflict Minerals ¹⁾

Mechanical Data ¹⁾

Taped and reeled 3000 / 7ⁿ
 Weight approx. 0.01 g
 Case material UL 94V-0
 Solder & assembly conditions 260°C/10s
 MSL = 1

Typische Anwendungen

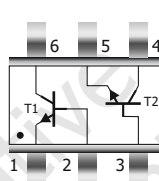
Signalverarbeitung,
 Schalten, Verstärken
 Standardausführung ¹⁾

Besonderheiten

Zwei Transistoren in einem Gehäuse
 Universell anwendbar
 Konform zu RoHS, REACH,
 Konfliktmineralien ¹⁾

**Mechanische Daten ¹⁾**

Gegurtet auf Rolle
 Gewicht ca.
 Gehäusematerial
 Löt- und Einbaubedingungen

Dual Transistors	<p>T1 1 = E1 2 = B1 6 = C1</p>  <p>T2 3 = B2 4 = C2 5 = E2</p>	Type Code BC672S XN
------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------

Maximum ratings ²⁾**Grenzwerte ²⁾**

			BC672S
Collector-Emitter-voltage – Kollektor-Emitter-Spannung	B open	V_{CE0}	18 V
Collector-Base-voltage – Kollektor-Basis-Spannung	E open	V_{CBO}	30 V
Emitter-Base-voltage – Emitter-Basis-Spannung	C open	V_{EBO}	3 V
Power dissipation – Verlustleistung		P_{tot}	150 mW ³⁾
Collector current – Kollektorstrom	DC	I_C	50 mA
Junction temperature – Sperrschichttemperatur		T_S	-55...+150°C
Storage temperature – Lagerungstemperatur		T_j	-55...+150°C

1 Please note the [detailed information on our website](#) or at the beginning of the data book

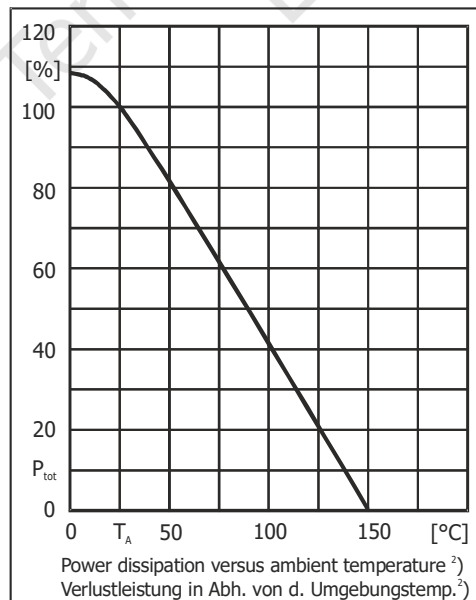
Bitte beachten Sie die [detaillierten Hinweise auf unserer Internetseite](#) bzw. am Anfang des Datenbuches

2 $T_A = 25^\circ\text{C}$ and per transistor, unless otherwise specified – $T_A = 25^\circ\text{C}$ und pro Transistor, wenn nicht anders angegeben

3 Mounted on P.C. board with 3 mm² copper pad at each terminal
 Montage auf Leiterplatte mit 3 mm² Kupferbelag (Löt-pad) an jedem Anschluss

Characteristics
Kennwerte

		$T_j = 25^\circ\text{C}$	Min.	Typ.	Max.
DC current gain – Kollektor-Basis-Stromverhältnis					
$V_{CE} = 10\text{ V}$	$I_C = 10\text{ mA}$	h_{FE}	100	–	200
Collector-Emitter saturation voltage – Kollektor-Sättigungsspannung ¹⁾					
$I_C = 20\text{ mA}$	$I_B = 4\text{ mA}$	V_{CEsat}	–	–	500 mV
Collector-Base breakdown voltage – Kollektor-Basis Durchbruchspannung ¹⁾					
$I_C = 10\text{ }\mu\text{A}$	E open	$V_{(BR)CBO}$	30 V	–	–
Collector-Emitter breakdown voltage – Kollektor-Emitter Durchbruchspannung ¹⁾					
$I_C = 1\text{ mA}$	B open	$V_{(BR)CEO}$	18 V	–	–
Base-Emitter breakdown voltage – Basis-Emitter Durchbruchspannung ¹⁾					
$I_E = 10\text{ }\mu\text{A}$	C open	$V_{(BR)BEO}$	3 V	–	–
Collector-Base cutoff current – Kollektor-Basis-Reststrom					
$V_{CB} = 10\text{ V}$	E open	I_{CBO}	–	–	500 nA
Emitter-Base cutoff current – Emitter-Basis-Reststrom					
$V_{EB} = 2\text{ V}$	C open	I_{EBO}	–	–	500 nA
Gain-Bandwidth Product – Transitfrequenz					
$V_{CE} = 10\text{ V}$	$I_C = 10\text{ mA}$, $f = 200\text{ MHz}$	f_T	600 MHz	–	–
Collector-Base Capacitance – Kollektor-Basis-Kapazität					
$V_{CB} = 10\text{ V}$	$I_E = i_e = 0$, $f = 1\text{ MHz}$	C_{CBO}	–	–	1.6 pF
Typical thermal resistance junction to ambient (per device) Typischer Wärmewiderstand Sperrschicht – Umgebung (pro Bauteil)		R_{thA}	420 K/W ²⁾		



Disclaimer: See data book page 2 or [website](#)
Haftungsausschluss: Siehe Datenbuch Seite 2 oder [Internet](#)

- 1 Tested with pulses $t_p = 300\text{ }\mu\text{s}$, duty cycle $\leq 2\%$ – Gemessen mit Impulsen $t_p = 300\text{ }\mu\text{s}$, Schaltverhältnis $\leq 2\%$
- 2 Mounted on P.C. board with 3 mm^2 copper pad at each terminal
Montage auf Leiterplatte mit 3 mm^2 Kupferbelag (Löt-pad) an jedem Anschluss

X-ON Electronics

Largest Supplier of Electrical and Electronic Components

Click to view similar products for [Bipolar Transistors - BJT category](#):

Click to view products by [Diodec manufacturer](#):

Other Similar products are found below :

[619691C](#) [MCH4017-TL-H](#) [BC546/116](#) [BC557/116](#) [BSW67A](#) [NTE158](#) [NTE187A](#) [NTE195A](#) [NTE2302](#) [NTE2330](#) [NTE63](#) [C4460](#)
[2SA1419T-TD-H](#) [2SA1721-O\(TE85L,F\)](#) [2SA2126-E](#) [2SB1204S-TL-E](#) [2SC5488A-TL-H](#) [2SD2150T100R](#) [SP000011176](#) [2N2369ADCSM](#)
[2N5769](#) [2SC2412KT146S](#) [2SC5490A-TL-H](#) [2SD1816S-TL-E](#) [2SD1816T-TL-E](#) [CMXT2207 TR](#) [CPH6501-TL-E](#) [MCH4021-TL-E](#)
[US6T6TR](#) [NJL0281DG](#) [732314D](#) [CMXT3906 TR](#) [CPH3121-TL-E](#) [CPH6021-TL-H](#) [873787E](#) [IMZ2AT108](#) [UMX21NTR](#) [MCH6102-TL-E](#)
[NJL0302DG](#) [TTA1452B,S4X\(S](#) [2N3583](#) [NTE103](#) [30A02MH-TL-E](#) [NSV40301MZ4T1G](#) [NTE101](#) [NTE13](#) [NTE15](#) [NTE16001](#) [NTE16006](#)
[NTE26](#)